文章编号: 1004-0609(2013)06-1681-13

## 复杂介质条件下 CSAMT 最小发收距的选择

汤井田<sup>1,2</sup>,周 聪<sup>1,2</sup>,肖 晓<sup>1,2</sup>

(1. 中南大学 有色金属成矿预测教育部重点实验室,长沙 410083;
 2. 中南大学 地球科学与信息物理学院,长沙 410083)

**摘 要:**提出利用 CSAMT 与 MT 的响应相对误差来区分 CSAMT 近区、过渡区与远区场数据的方法,考虑发收 距 *r*、测量角度 *φ*、测深频率 *f*、覆盖层厚度 *h*<sub>1</sub>和各层电阻率等因素。通过 3 种数值模型,讨论复杂介质条件下最 小发收距 *r*<sub>min</sub> 的选择方案。结果表明:均匀半空间模型中,*r*<sub>min</sub> 的值可精确给定;两层介质时,*r*<sub>min</sub> 的选择需根据 勘探深度分情况讨论;多层介质时,可等效成两层介质进行估计。 关键词:地球物理;电磁勘探;可控源音频大地电磁法;复杂介质;测量范围;发收距

中图分类号: P631.3 文献标志码: A

# Selection of minimum transmit-receive distance of CSAMT on complicated media

TANG Jing-tian<sup>1, 2</sup>, ZHOU Cong<sup>1, 2</sup>, XIAO Xiao<sup>1, 2</sup>

(1. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals, Ministry of Education,

Central South University, Changsha 410083, China;

2. School of Info-physics and Geomatics Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)

**Abstract:** A method used to identify the near-field area, transition-field area and the far-filed area were proposed by the relative error of the responses of the CSAMT and MT. The transmit-receive distance r, angle  $\varphi$ , frequency f, overburden thickness  $h_1$  and resistivity of each layer were considered. The approaches used to select the optimal  $r_{\min}$  were demonstrated based on three numerical models. The results show that, on homogeneous half-space,  $r_{\min}$  can be given precisely. On two layer model,  $r_{\min}$  is calculated by different cases with different exploration depth. On multi-layer model,  $r_{\min}$  can be estimated by a equivalent two layered model.

**Key words:** geophysics; electromagnetic prospecting; controlled source audio-frequency magnetotelluric; complicated media; measure zone; transmit-receive distance

近年来,可控源音频大地电磁法(Controlled source audio-frequency magnetotelluric, CSAMT)因其理论方法、数据处理技术和实用仪器的改善,在资源勘查等领域得到了迅速的发展及应用。相比无源的大地电磁法(Magnetotelluric, MT),由于引入了可控的电流源,

因而获得了很高的信噪比,并在合适的测量排列下具 备很高的工作效率。然而,同样由于源的引入,产生 了一系列与源有关的问题<sup>[1-6]</sup>,非平面波效应<sup>[2-3]</sup>即是 其中之一。很多学者对非平面波校正这一问题进行过 研究,如 UMESH<sup>[7]</sup>、曹昌祺<sup>[8]</sup>等分别提出过不同的视

基金项目:国家公益性行业基金资助项目(SinoProbe-03);中南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012zzts011);国家自然科学基金 资助项目(41174105)

收稿日期: 2012-02-03; 修订日期: 2013-04-19

通信作者:周 聪,博士研究生; E-mail:jttang@mail.csu.edu.cn

电阻率定义,汤井田等<sup>[9-10]</sup>在全区视电阻率的定义及应用方面作过大量研究。然而就目前的实际应用而言,野外作业时尽量保证在远区场观测依然是最为合理的方案。随着资源勘查日益走向深部,CSAMT的目标勘探深度也常被要求尽可能大。一些学者讨论了CSAMT对深部及多层条件下地电体的分辨情况<sup>[11-12]</sup>,很多应用实例<sup>[13-14]</sup>也论证了CSAMT对大深度勘探的有效性。但大深度的测量使得非平面波效应的问题更加凸显,实际工作中如设计不当,很难保证所有频率都在远区范围内。

为在保证信噪比的同时获取更多可用数据,合理 的观测方案设计是必要的, 而测量区域的选择是其中 的关键。一般的,依据背景为测区平均大地电阻率的 均匀半空间模型来进行测量区域的划定。如 ZONGE<sup>[15]</sup> 指出发收距大于波长的一半即3倍趋肤深度时可近似 认为进入远区。PFAFFHUBER<sup>[16]</sup>研究了均匀大地表面 上水平磁偶极子的远区电磁场距离与趋肤深度之间的 线性关系,并给出远区场距离估算公式。岳瑞永等[17] 讨论了方位各向异性对近、远区划分的影响。王若 等[18]分析了几种不同观测系统的电磁场特征,比较了 几种适宜复杂地形的观测方案的优缺点。陈明生等[19] 利用均匀半空间表面电磁场的闭合表达式,由地层波 与地面波之比给出了定量划分场区的方法。林威[20]探 讨水平电偶源条件下过渡区电磁场的特征,并提出在 实际工作中可利用卡尼亚视电阻率与电场视电阻率的 相交点作为过渡区数据的判断标志。通常而言,当测 区地质构造相对简单或探测深度要求不大时,依据均 匀半空间的结论得出的施工方案设计是合理的,可以 保证数据质量、高信噪比以及生产效率。但一方面, 即使是在均匀半空间中,目前依据感应数 p 进行的远 区、过渡区及近区的划分也并不精确:另一方面,对 于某些地质条件较复杂的测区,如基底电阻率很大时, 过小的发收距常常会导致过渡区数据采集过多, 使得 结果难以处理; 而基底电阻率很小时, 过大的发收距 又会使信号强度减弱, 信噪比降低。针对这一问题, 本文作者将对均匀水平层状介质表面电偶极子源测量 区域的选择进行讨论。

## 测量范围的限制因素与远区及过 渡区场数据的判别

CSAMT 测量中,有限场源的使用对在平面上允许采集数据的范围提出了一些限制。确定允许勘探范

围的因素有3个:1)最大发收距 r<sub>max</sub>,它受到给定噪 声条件下最小可测信号的制约;2)最小发收距 r<sub>min</sub>, 它受到进入过渡区与近区带的限制;3)信号强度与偏 离场源中垂线的方位角的依赖联系(对水平电偶源)。

通常,根据所要求的勘探深度以及测量区域的大 地电阻率(可据标本、露头、测井等估计)可确定最低 的探测频率f,以及合适的频率范围。由f,可得对应的 趋肤深度及所需的最小发收距rmin。理想的情况是rmin 尽可能地小,同时对使用的所有频率而言仍保持在远 区。而根据给定噪声条件下可探测的最小电场及磁场 强度,由电磁场值(E,H)与发收距r的关系式<sup>[1-2]</sup>可以 得到最大发收距rmax=F(Emin,Hmin)。另外,通过研究电 偶极源的电磁场分布特征,以避开场值微弱的区域为 原则可确定适合进行测量的方位角。

为进行合理的施工方案设计,准确地识别远区、 过渡区以及近区范围十分必要。一般根据电距离参数 进行分区划定,当发收距大于趋肤深度 3~5 倍时,认 为为远区场<sup>[15-20]</sup>。显然,这样的划分并不严格。对此, 利用 MT 响应与 CSAMT 响应进行对比以进行各区域 的划定。由于 MT 观测天然电磁场,不受非平面波效 应的影响,因此将其作为 CSAMT 远区与过渡区的判 别依据是可行的。定义参数:

$$e_{\rho}(\rho,h,r,\varphi,f) = \left| \frac{\rho_a^{\text{CSAMT}} - \rho_a^{\text{MT}}}{\rho_a^{\text{MT}}} \right| \times 100\%$$
(1)

$$e_{\varphi}(\rho,h,r,\varphi,f) = \left| \frac{\varphi_a^{\text{CSAMT}} - \varphi_a^{\text{MT}}}{\varphi_a^{\text{MT}}} \right| \times 100\%$$
(2)

式中: $\rho$ 、h、r、 $\varphi$ 、f分别为介质电阻率、水平 介质层的厚度、发收距、观测角度和观测频率。 $e_{\rho}$ 、  $e_{\varphi}$ 分别为同一地电模型对应于某一类 $\rho$ 、h、r、 $\varphi$ 、 f值时 CSAMT 与 MT 的响应视电阻率和相位的相对 误差; $\rho_{a}^{MT}$ 、 $\rho_{a}^{CSAMT}$ 和 $\varphi_{a}^{MT}$ 、 $\varphi_{a}^{CSAMT}$ 分别为相对应 的 MT 及 CSAMT 视电阻率及相位响应。

#### 2 水平均匀大地表面测量区域的选择

野外实际工作中,根据勘探目标设计观测区域与 频率范围,较完整的 CSAMT 测量数据常包含远区与 部分过渡区的数据。根据水平均匀大地表面各电磁场 分量的场值分布<sup>[2]</sup>及前文提出的相对误差  $e_{\rho}$ 、 $e_{\varphi}$ ,可 以准确地给出不同误差限下的测量区域范围。 图 1 所示为准静态条件下均匀半空间  $P_E = I(dL)/(2\pi) = 1$  (式中:  $P_E$ 为偶极矩的电偶极矩, I 为供电电流, dL 为电偶极源的长度)时 CSAMT 与 MT 的视电阻率及相位相对误差在大地表面的分布 图。图 1(a)、(b)、(c)及(d)分别表示 $e(\rho_{xy})$ 、 $e(\rho_{yx})$ 、  $e(\varphi_{xy})$ 、 $e(\varphi_{yx})$ 的分布。 $e(\rho_{xy})$ 表示xy方向视电阻率 的相对误差,其他变量的含义与此类似。 $P_E$ 代表归一 化的发射参数,  $\delta$ 为屈服深度(N 代表层数)。其中电 偶源的中心位置在(0,0)且垂直y轴放置,  $\delta_1 = \sqrt{2\rho_1/(\mu_0 \omega)}$ 为准静态条件下的趋肤深度, $\mu_0$ 为 大地的磁导率,x、y分别为与中心位置的距离。

从图 1 可以得出以下信息: 1) 对于  $E_x / H_y$ 测量,  $\varphi \in [30^\circ, 45^\circ]$ 的角域范围内相对误差  $e(\rho_{xy})$ 的值较 大,不适合进行测量;对于  $E_y / H_x$ 测量,不宜进行测 量的角域则为 $\varphi = [0, 5^\circ] \cup [85^\circ, 90^\circ]$ 。相对误差大的角 域与电磁场值微弱的区域<sup>[1-2]</sup>是一致的,施工设计时应 当避开这些角域。2) 在相同的误差限下,与相位相比, 依视电阻率的相对误差分布所得的最小发收距  $r_{min}$  的 取值要更小,说明相位数据对源的影响更敏感;考虑 到实际工作中视电阻率数据更受关注,下文中主要利 用视电阻率进行讨论,而如果对相位数据有同样的要 求,则 $r_{min}$ 的取值必须更大。3) 总体而言,随着发收 距r的减小,误差呈逐渐增大的趋势。表 1 给出不同 视电阻率误差限要求下最小发收距 $r_{min}$ 的数值。在野 外可根据不同的数据要求来选择 $r_{min}$ 。可以看出,汤 井田等<sup>[1-2]</sup>给出的选择结果大约对应于 10%的误差限。 而如果测量结果中要求误差限更小,则必须将最小发 收距的数值取得更大,对于野外常用的赤道 $E_x/H_y$ 测 量,只有满足 $r_{min} > 7\delta$ 时,才能保证数据误差限仅 为 1%。



图1 CSAMT 与 MT 的视电阻率、相位相对误差在均匀大地表面的分布图

**Fig. 1** Distribution of relative error of CSAMT and MT apparent resistivity on homogeneous halfspace  $(P_{\rm E} = I(dL)/(2\pi) = 1, \delta_1 = \sqrt{2\rho_1/(\mu_0\omega)})$ : (a) Distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (b) Distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (c) Distribution of  $e(\varphi_{xy})$ ; (d) Distribution of  $e(\varphi_{yx})$ 

1684		2013年6月			
表1 均匀半空间时不同视电阻率	率误差限要求下最小	、发收距 r <sub>min</sub> 的值			
<b>Table 1</b> Value of $r_{\min}$ by restriction	n of different appare	ent resistivity errors	on halfspace		
Measuring arrangement	r <sub>min</sub>				
	1%	2%	5%	10%	20%
Equatorial $E_x/H_y$ array	$7.1\delta$	6.68	5.68	3.48	3.08
Longitudinal $E_x/H_y$ array	$7.6\delta$	$7.0\delta$	$5.1\delta$	$4.7\delta$	$4.3\delta$

6.0*ð* 

## 3 均匀水平两层介质表面最小发收 距的选择

6.4*δ* 

 $E_v/H_x$  array

层状介质条件下,模型参数与观测参数之间的关 系更复杂,测量区域的选择需要考虑更多因素。为简 单起见,先将问题简化为水平两层介质条件。两层时, 需要考虑:发收距*r*,测量角度 $\varphi$ ,测深频率*f*,覆盖 层厚度 *h*<sub>1</sub>,基底与覆盖层的电阻率之比 $\mu = \rho_2 / \rho_1$ 。 对于 $\mu$ 值的影响,不妨先取两种理想情况加以研究, 即基底良导( $\mu = 0$ )和基底绝缘( $\mu = \infty$ )。可以推测其 他 $\mu$ 值条件的影响范围应介于这两者和 $\mu = 1$ (即均匀 半空间)之间。下面先分析两种理想情况下 CSAMT 的 电磁场计算方法及地表视电阻率值的求取方案。

#### 3.1 均匀水平两层理想模型上电偶极子电磁场的计 算方法

均匀水平两层介质模型如图 2 所示。一水平电偶 极子(接地导线)位于层状介质表面,偶极矩为 *P=IdL(I* 为谐变电流)。选取公共坐标原点 *O* 位于偶极子中心 的直角坐标系,使 *x* 轴指向偶极矩方向(即 *φ=0* 的方 向), *z* 轴垂直向下。



图 2 均匀水平两层模型上的水平电偶极子

Fig.2 Electric dipole on two-layer model

当 $\rho_2 = 0$ 或 $\rho_2 = \infty$ 时,即为基地为良导或绝缘的两种理想情况。

在电(磁)测深中,各种方法对地电断面的反应完

全取决于空间频率特性函数。直流电测深、大地电磁 测深和人工源电磁测深的根本异同主要体现在各自的 空间频率特性函数上,源只是外在的表现形式。

2.6*δ* 

 $2.4\delta$ 

5.2*δ* 

CSAMT 的空间频率特性函数(R\*、R)为[1-2]

$$R^* = \operatorname{coth}[m_1h_1 + \operatorname{coth}^{-1}\frac{m_1}{m_2}\operatorname{coth}(m_2h_2 + \dots + \operatorname{coth}^{-1}\frac{m_{N-1}}{m_2})]$$
(3)

$$m_N$$

$$R = \coth[m_1h_1 + \coth^{-1}\frac{m_1}{m_2}\frac{\rho_1}{\rho_2}\coth(m_2h_2 + \dots +$$

$$\coth^{-1}\frac{m_{N-1}}{m_N}\frac{\rho_{N-1}}{\rho_N})]$$
(4)

$$m_j = \sqrt{m^2 - k_j^2} ; \quad k_j^2 = i\omega\mu / \rho_j$$
(5)

式中: *m* 称为空间频率, 它具有距离 *r* 倒数的量纲; i 为虚数单位; ω 为角频率; *N* 为水平多层的层数。

可以发现, CSAMT 的空间频率特性函数与观测 角度φ没有关系,或者说地表电磁场随地下介质电阻 率或厚度等参数的变化关系不受观测角度φ的影响。 因此,层状条件下观测角域的选择与均匀半空间类似, 这里不再赘述。

当层数 N=1 时,即模型为均匀半空间时,有 R<sup>\*</sup>=1, R=1;

当层数 *N*=2 时,即模型为两层介质时,可分为两 种类型: D型(ρ<sub>1</sub> > ρ<sub>2</sub>)和 G型(ρ<sub>1</sub> < ρ<sub>2</sub>)。将第二层 视为均匀半空间,则其顶部处的空间频率特性函数为

$$R_2^*(h_1) = 1 \tag{6}$$

$$R_2(h_1) = 1 (7)$$

由式(3)和(4)可知:

$$R_{1}^{*}(0) = \operatorname{coth}\left[m_{1}h_{1} + \operatorname{coth}^{-1}\frac{m_{1}}{m_{2}}R_{2}^{*}(h_{1})\right]$$
(8)

$$R_{1}(0) = \operatorname{coth}\left[m_{1}h_{1} + \operatorname{coth}^{-1}\frac{m_{1}\rho_{1}}{m_{2}\rho_{2}}R_{2}(h_{1})\right]$$
(9)

变换可得

$$coth(x + y) = \frac{1 + \coth x \coth y}{\coth x + \coth y}$$
由式(6)和(7)可得:

$$R_{1}(0) = \frac{1}{m_{1}/m_{2} + \coth(m_{1}h_{1})}$$
(10)

$$R_{1}(0) = \frac{1 + [m_{1}\rho_{1}/(m_{2}\rho_{2})] \operatorname{coth}(m_{1}h_{1})}{[m_{1}\rho_{1}/(m_{2}\rho_{2})] + \operatorname{coth}(m_{1}h_{1})}$$
(11)

1) 当 
$$\rho_2 = 0$$
 时,由式(5)可知:

$$m_2 = \infty$$
,  $m_1/m_2 = 0$ ,  
 $\frac{m_1\rho_1}{m_2\rho_2} = \frac{\rho_1\sqrt{m^2 - i\omega\mu/\rho_1}}{\rho_2\sqrt{m^2 - i\omega\mu/\rho_1}} = \infty$ ,  
将其代入式(10)和(11)中有

$$R_{1}^{*}(0) = \frac{1}{\coth(m_{1}h_{1})} = \tanh(m_{1}h_{1})$$
(12)

$$R_1(0) = \operatorname{coth}(m_1 h_1) \tag{13}$$

当 ρ<sub>2</sub> =∞ 时,由式(5)知

 $m_2 = m$ ,  $m_1 / m_2 = m_1 / m$ ,

$$\frac{m_1\rho_1}{m_2\rho_2} = \frac{m_1\rho_1}{m\rho_2} = 0,$$
  
将其代入式(10)和(11)中有

$$R_1^*(0) = \frac{1 + (m_1 + m_2) \operatorname{con}(m_1 n_1)}{m_1 / m + \operatorname{coth}(m_1 h_1)}$$
(14)

$$R_{1}(0) = \frac{1}{\coth(m_{1}h_{1})} = \tanh(m_{1}h_{1})$$
(15)

以上即是  $\rho_2 = 0 \ \pi \rho_2 = \infty$ 时的空间频率特性函数的计算式,将  $R_1^*(0) \ \pi R_1(0)$ 的值代入水平分层大地表面上谐变偶极子的电磁场各分量计算表达式<sup>[1-2]</sup>中,即可得这两种理想情况下的电磁场响应,进而可求得这两类条件下的视电阻率值。

#### **3.2** 均匀水平两层理想模型表面最小发收距的选择 3.2.1 良导基底与绝缘基底的情况

图 3 所示为两种理想情况下 CSAMT 与 MT 的视 电阻率相对误差  $e(\rho_{xy})$  和  $e(\rho_{yx})$  随  $r/\delta_1 Q \delta_1/h_1$  变化 的分布图,  $\delta_1$  为电磁波在第一层介质中的趋肤深度。 图中的虚线表示电阻率为  $\rho_1$  的均匀半空间中  $r/\delta_1$  在 1%的误差限处的取值。

设两层介质时选择的最小发收距为 r<sub>min</sub>(n=2),而 依据背景电阻率等于覆盖层电阻率 ρ<sub>1</sub> 的均匀半空间 所选择的最小发收距为 $r_{\min}(n=1,\rho_1)$ ,其中 n 表示层 数。由图3可看出:1) 层状条件下,各误差限下发收 距r与趋肤深度 $\delta_1$ 之间的简单线性关系不再成立;只 有当 $\delta_1/h_1$ 一定时,不同误差限控制的 $r/\delta_1$ 值才不变。 2) 若 $\delta_1/h_1 \ll 1$ ,则各误差限处有 $r_{\min}(n=2)=$  $r_{\min}(n=1,\rho_1);$ 如图 3(a)中在 1%的误差限下,当  $\delta_1 / h_1 < 0.2$ 时,随着 $\delta_1 / h_1$ 的减小 $r / \delta_1$ 的值不再变化, 且与电阻率为ρ,的均匀半空间条件下相同。说明当趋 肤深度很小电磁波不足以穿透第一层时,测量相当于 在均匀半空间中进行,下层基底的影响可以忽略。3) 若 $\delta_1/h_1 \gg 1$ ,对良导基底,有 $r_{\min}(n=2) < r_{\min}$  $(n = 1, \rho_1)$ 。如图 3(a)中在 1%的误差限下,当 $\delta_1 / h_1 >$ 2.8 时,随着 $\delta_1/h_1$ 的增大, $r/\delta_1$ 的值逐渐变小,并且 其值小于电阻率为ρ,的均匀半空间条件下的取值。对 绝缘基底, 若 $\delta_1/h_1 > 1$ , 则 $r_{\min}(n=2) > r_{\min}(n=1, \rho_1)$ 。 这说明当趋肤深度很大、电磁波主要在基底中衰减时, 各误差限对应的最小发收距主要受基底影响,良导基 底对应的最小发收距更小; 而绝缘基底对应的最小发 间内有  $r_{\min}(n=2) \ge r_{\min}(n=1,\rho_1)$ , 仅当  $\delta_1 / h_1 \approx 0.6$  时 的一个非常狭窄的区间内在部分误差限下有  $r_{\min}(n=2) < r_{\min}(n=1,\rho_1)$ 。如图 3(a)中 1%的误差限 下,在 0.2 $<\delta_1/h_1 \leq 2.8$  的范围内,随着  $\delta_1/h_1$  的增大,  $r/\delta_i$ 值的整体趋势是先增大后减小,并且其值大于电 阻率为ρ,的均匀半空间条件下的取值。对绝缘基底, 在  $\delta_1 / h_1 \approx 1$  的 大 部 分 区 间 内 ,  $r_{\min}(n=2) >$  $r_{\min}(n=1,\rho_1);$  仅在 0.2< $\delta_1/h_1 < 1$  间的一个非常狭 窄的区间内有 $r_{\min}(n=2) \leq r_{\min}(n=1,\rho_1)$ 。对于实际工 作设计而言,如果目标探测深度要求达到覆盖层以下, 则小区间内的特殊情况基本可以忽略。这说明当趋肤 深度大致与覆盖层厚度相当时,电磁波的衰减同时受 上下两层及分界面的影响,并且这种影响对 CSAMT 较 MT 更大。5) 可以发现,在良导基底的理想情况下, 在一定的研究范围内(趋肤深度约为覆盖层厚度的2~6 倍),对于某一误差限(特别对 E<sub>x</sub>/H<sub>y</sub> 测量) r/δ<sub>1</sub>及  $\delta_1 / h_1$ 的变化近似成反比,或者说此时  $r_{\min} / h_1$  为常数。 如对图 3(a)所示的 10%的误差限,  $r_{\min}/h_1 \approx 6$ 。这说 明,对于良导基底,若频率足够低,电磁波透入第二 层后会很快衰减,此时的 rmin 的取值仅与覆盖层厚度 有关而与测量频率及覆盖层电阻率无关。6) 对于野外 常用的赤道 $E_x/H_y$ 测量,观测角度 $\varphi$ 对误差 $e(\rho_{xv})$ 的分 布形态影响不大,相对而言,在 $\varphi = \pi/2$ 处各误差限 对应的 r<sub>min</sub> 值更小; 在测线平行偶极矩方向布置时,





**Fig. 3** Distribution of relative error of CSAMT and MT apparent resistivity with constraint of  $r/\delta_1$  and  $\delta_1/h_1$  on two-layered earth (dashed line represents value of  $r/\delta_1$  on homogeneous half space with resistivity of  $\rho_1$  while restriction error is 1%): (a)  $\rho_2=0$ ,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (b)  $\rho_2=0$ ,  $\varphi=\pi/3$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (c)  $\rho_2=0$ ,  $\varphi=0$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (d)  $\rho_2=0$ ,  $\varphi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (e)  $\rho_2=\infty$ ,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (f)  $\rho_2=\infty$ ,  $\varphi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ;

可以仅考虑 $\varphi = \pi/2 \pounds r_{min}$ 的取值。轴向 $E_x/H_y$ 测量及  $E_y/H_x$ 测量与赤道 $E_x/H_y$ 测量相比,各误差限下的 $r_{min}$ 更小,并且这种差异在良导基底的模型条件下更加明 显。说明在高山峡谷等复杂地形条件下,考虑非常规 的测量排列可能会使对应误差限下的可测范围更广。 以上所述几种情况详见表 2。需要指出的是,以

表2 两层介质时的最小发收距	r <sub>min</sub> 的值
----------------	---------------------

**Table 2**Value of  $r_{\min}$  on two-layered earth

Base type	$\delta_1/h_1 << 1$	$\delta_1/h_1 \approx 1$	$\delta_1/h_1 >> 1$
Perfect conductor	$r_{\min}(n=2)=r_{\min}(n=1, \rho_1)$	Most of range, $r_{\min}(n=2) \ge r_{\min}(n=1, \rho_1)$	$r_{\min}(n=2) < r_{\min}(n=1, \rho_1)$
Low resistance	$r_{\min}(n=2)=r_{\min}(n=1, \rho_1)$	Most of range, $r_{\min}(n=2) \ge r_{\min}(n=1, \rho_1)$	$r_{\min}(n=1, \rho_2) \leq r_{\min}(n=2) < r_{\min}(n=1, \rho_1)$
High resistance	$r_{\min}(n=2)=r_{\min}(n=1, \rho_1)$	Most of range, $r_{\min}(n=1, \rho_1) < r_{\min}(n=2) < r_{\min}(n=1, \rho_2)$	$r_{\min}(n=2) \ge r_{\min}(n=1, \rho_2) \ge r_{\min}(n=1, \rho_1)$
Insulator	$r_{\min}(n=2)=r_{\min}(n=1, \rho_1)$	Most of range, $r_{\min}(n=2) > r_{\min}(n=1, \rho_1)$	$r_{\min}(n=2) > r_{\min}(n=1, \rho_1)$

Annotation:  $r_{\min}(n=2)$  represents  $r_{\min}$  on two-layered earth;  $r_{\min}(n=1, \rho_1)$  and  $r_{\min}(n=1, \rho_2)$  represents  $r_{\min}$  on homogeneous half space with resistivity of  $\rho_1$  and  $\rho_2$ , respectively. Although values of  $r_{\min}(n=2)$  are only given in most of range when  $\delta_1/h_1 \approx 1$ , as mentioned in above, situation of other range can be ignored for design of practical work.

上虽为 φ 为几个特殊值时所得到的一些结果,但如前 所述,由于 CSAMT 反应层状信息的空间频率特性函 数与观测角度 φ 没有关系,故当 φ 角在其他角域变化 时(应避开场值较弱不适合进行测量的角域)可以得到 类似的结果。

3.2.2 非理想条件均匀水平两层介质的情况

前文之所以首先讨论两种理想情况下发收距的选择,是基于非理想条件两层介质的情况应介于均匀半空间与这两种理想情况之间的假设。下面就非理想条件两层介质的情况做一些讨论。同样,设两层介质时选择的最小发收距为 $r_{min}(n=2)$ ,而依据背景电阻率等于覆盖层电阻率 $\rho_1$ 的均匀半空间所选择的最小发收距为 $r_{min}(n=1,\rho_1)$ ,依据背景电阻率等于基底电阻率 $\rho_2$ 的均匀半空间所选择的最小发收距为 $r_{min}(n=1,\rho_2)$ ,其中n表示层数。

图 4 所示为 $\mu = [0.01, 0.1, 2, 10]$ 时 $e(\rho_{xv})$ 、 $e(\rho_{vx})$ 随 $r/\delta_1$ 及 $\delta_1/h_1$ 变化的分布。由图 4 可以看出: 1) 总 的来说,非理想条件低阻及高阻基底情况下 $e(\rho_m)$ 、  $e(\rho_{vx})$ 随  $r/\delta_{I}$  及  $\delta_{I}/h_{I}$  变化的分布规律与理想条件时 基本一致; 根据最低探测频率 f. 或最大趋肤深度  $(\delta_1)_{max}$ 的不同,最小发收距  $r_{min}$ 的选择具有 3 种不同 的情况。2) 若 $\delta_1/h_1 \ll 1$ ,则各误差限处有  $r_{\min}(n=2) = r_{\min}(n=1,\rho_1)$ 。3) 若 $\delta_1 / h_1 \gg 1$ , 对低阻 基底, 有 $r_{\min}(n=1,\rho_2) \leq r_{\min}(n=2) < r_{\min}(n=1,\rho_1);$ 对高阻基底, 若 $\delta_1/h_1 \gg 1$ , 则 $r_{\min}(n=2) \ge r_{\min}$  $(n=1, \rho_2) > r_{\min}(n=1, \rho_1)$ 。4) 若 $\delta_1 / h_1 \approx 1$ , 对低阻基 底,大部分区间内有 $r_{\min}(n=2) \ge r_{\min}(n=1,\rho_1);$ 对高 阻基底, 在 $\delta_1 / h_1 \approx 1$ 的大部分区间内,  $r_{\min}(n = 1, \rho_1) <$  $r_{\min}(n=2) < r_{\min}(n=1,\rho_2); \ (2 \le \delta_1 / h_1 \le 1)$ 的一个非常狭窄的区间内有 r<sub>min</sub>(n=2) ≤  $r_{\min}(n=1, \rho_1)$ 。5) 对低阻基底,  $\mu = 0$ 、  $\mu = 0.01$  与

为进一步证明非理想条件下两层介质的情形介于 理想条件和均匀半空间之间,下面讨论 µ 值变化时,  $r_{\min}(n=2)$ 的取值。图 5 所示为给定  $h_1$ 、  $\rho_1$  的值在几 组不同的发收距 r 取值下 CSAMT 与 MT 的视电阻率 相对误差 $e(\rho_{xv})$ 、 $e(\rho_{vx})$ 与 $r/\delta$ 及 $\mu$ 值的变化关系图。 由图 5 可知: 1) 非理想条件下,对 D 型断面,各误 差限对应的 $r/\delta_1$ 的取值基本处于 $\mu = 1 \mathcal{D} \mu = 0$ 两种情 况之间。较小的误差限下 $r/\delta_1$ 的取值随 $\mu$ 的减小大致 递增,在 $\mu = 0$ 处取得最大值;而较大的误差限下 $r/\delta_1$ 的取值随 $\mu$ 的减小而不断减小,在 $\mu = 0$ 处取得最小 值。r/δ<sub>1</sub>的这种取值趋势随 r/h<sub>1</sub>的增大而由前者向后 者过渡。特别的,当  $r/h_1 \leq 1$ 时, $r/\delta_1$ 的取值与 $\mu = 1$ 即均匀半空间时类似, 各误差限下 r/δ, 的近似值可参 见表 1。当 $r/h_1 \gg 1$ 时,  $r/\delta_1$  在较大的误差限下随  $\mu$ 的减小而递减; 2) 对 G 型断面, 各误差限对应的 $r/\delta_1$ 的取值相对简单,一般的, $r/\delta_i$ 的取值随 $\mu$ 的增大而 递增,在μ=∞处取得最大值。因此,非理想情况的 rmin 取值范围基本在两种理想情况与均匀半空间之间。

实际工作中, $\rho_1$ 的获取是比较方便的,可以利用 标本测量、露头或坑道小四极测量、测井等方法;而  $h_1$ 和 $\rho_2$ 等参数则可通过钻孔等先验资料推测;当 $h_1$ 和 $\rho_2$ 等参数无法预估时,也可根据区域地质情况推知 基底类型。一般的,当勘探深度远小于覆盖层厚度 ( $\delta_1 \ll h_1$ )时,基底的影响较小,最小发收距 $r_{min}$ 的选 择与背景电阻率为覆盖层电阻率( $\rho_1$ )的均匀半空间情 形一致( $r_{min}$ (n=2)= $r_{min}$ ( $n=1,\rho_1$ ))。当勘探深度与覆



图 4 两层介质表面 CSAMT 与 MT 的视电阻率相对误差随  $r/\delta_1 \mathcal{D} \delta_1/h_1$  变化的分布

**Fig. 4** Distribution of relative error of CSAMT and MT apparent resistivity with constraint of  $r/\delta_1$  and  $\delta_1/h_1$  on two-layered earth (dashed line represents value of  $r/\delta_1$  on homogeneous half space with resistivity of  $\rho_1$  while restriction error is 1%; dot-dashed line represents value of  $r/\delta_1$  on homogeneous half space with resistivity of  $\rho_2$  while restriction error is 1%;  $r/\delta_1 = r\delta_2/\delta_2\delta_1 = \sqrt{\rho_2/\rho_1}r/\delta_2$ ): (a)  $\mu$ =0.01,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (b)  $\mu$ =0.1,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (c)  $\mu$ =2,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (d)  $\mu$ =10,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (e)  $\mu$ =0.1,  $\varphi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (f)  $\mu$ =2,  $\varphi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ;



图 5 两层介质表面 CSAMT 与 MT 的视电阻率相对误差与 $\mu$ 及 $r/\delta$ 的变化关系

**Fig. 5** Distribution of relative error of CSAMT and MT apparent resistivity with constraint of  $\mu$  and  $r/\delta$  on two-layered earth: (a)  $r/h_1=3$ ,  $\varphi=\pi/2$ ; distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (b)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/2$ ; distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (c)  $r/h_1=30$ ,  $\varphi=\pi/2$ ; distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (d)  $r/h_1=3$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (e)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (f)  $r/h_1=30$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (g)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=30$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ; distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (h)  $r/h_1=12$ ,  $\varphi=\pi/4$ ;

盖层厚度相当( $\delta_1/h_1 \approx 1$ )时,对低阻基底, $r_{\min}$ 的取值 需大于背景电阻率为 $\rho_1$ 的均匀半空间时的情形 ( $r_{\min}(n=2) \ge r_{\min}(n=1,\rho_1)$ );对高阻基底, $r_{\min}$ 的取 值则介于背景电阻率分别为 $\rho_1$ 和 $\rho_2$ 的两种均匀半空 间 情 形 之 间 ( $r_{\min}(n=1,\rho_1) < r_{\min}(n=2) < r_{\min}(n=1,\rho_2)$ )。当勘探深度远大于覆盖层厚度 ( $\delta_1 >> h_1$ )时,对低阻基底, $r_{\min}$ 的取值介于背景电阻 率分别为 $\rho_1$ 和 $\rho_2$ 的两种均匀半空间情形之间 ( $r_{\min}(n=1,\rho_2) \le r_{\min}(n=2) < r_{\min}(n=1,\rho_1)$ );对于高 阻基底, $r_{\min}$ 较均匀半空间时必须更大( $r_{\min}(n=2) \ge r_{\min}(n=1,\rho_2) \ge r_{\min}(n=1,\rho_1)$ )。 $r_{\min}$ 的取值情况详见 表 2。

## 4 均匀水平多层介质表面发收距的 选择

图 6 所示为均匀水平四层 HK 及 KH 模型条件下

CSAMT与MT的视电阻率相对误差随 $r/\delta_1 Q \delta_1/h_1$ 变化的分布图。由图 6 可看出,多层条件下的结果与两 层条件时基本是类似的,随着频率的降低,也即 $\delta_1/h_1$ 值的增大,各误差限处 $r/\delta_1$ 的取值特点依次与 D 型或 G 型模型相对应。一般的, $r_{min}$ 的值主要取决于 ( $\delta_1$ )<sub>max</sub>/ $h_1$ 。同样, $\delta_1/h_1 \gg 1$ 时,低阻层使得误差限 对应的可测范围更大,而高阻层则相反,且这种影响 随着电阻率差异和层厚的增大而增大。将基底上方各 层等效为均匀的一层覆盖层可以将这种影响做一粗略 的估计。等效电阻率和厚度计算方法为

$$H = h_1 + h_2 + \dots + h_n,$$
  

$$S = h_1 / \rho_1 + h_2 / \rho_2 + \dots + h_{n-1} / \rho_{n-1},$$
  

$$\overline{\rho} = H / S$$

图 7 所示为 CSAMT 与 MT 的视电阻率相对误差 在均匀水平四层 HK 及 KH 模型及其等效两层模型表 面的分布图。由图 7 可以看出,这种等效的估计方法 在 5%和 10%的误差限下对 rmn 的判断是可以接受的。



图 6 水平四层模型 CSAMT 与 MT 的视电阻率相对误差随  $r/\delta_1 \mathcal{D} \delta_1/h_1$  变化的分布

**Fig. 6** Distribution of relative error of CSAMT and MT apparent resistivity with constraint of  $r/\delta_1$  and  $\delta_1/h_1$  on four-layered models: (a)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=600 \ m$ ,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (b)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=600 \ m$ ,  $\varphi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (c)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ ,  $h_3=300 \ m$ ,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (d)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ ,  $h_3=300 \ m$ ,  $\varphi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (d)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ ,  $h_2=300 \ m$ ,  $h_3=300 \ m$ ,  $\varphi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (d)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ ,  $h_2=300 \ m$ ,  $\phi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (d)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ ,  $h_3=300 \ m$ ,  $\varphi=\pi/4$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ 



图 7 四层及其等效两层模型表面 CSAMT 与 MT 的视电阻率相对误差分布

**Fig.** 7 Distribution of relative error of CSAMT and MT apparent resistivity on surface of four-layered and its equivalent two layered models: (a)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=100 \ m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ ,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (b)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ ,  $\varphi=\pi/2$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (c)  $\rho_1=27 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (c)  $\rho_1=27 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=300 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (e)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (f)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_3=10 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_1=100 \ m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{xy})$ ; (f)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (f)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (f)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (f)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ ; (f)  $\rho_1=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_2=1 \ 000 \ \Omega \cdot m$ ,  $\rho_4=100 \ \Omega \cdot m$ ,  $h_2=100 \ m$ ,  $h_3=100 \ m$ , distribution of  $e(\rho_{yx})$ 

综上所述,当目标勘探深度范围内的介质层数较多时, 应尽可能多的收集先验信息,并依据这些信息进行综 合考量。当各层参数都能粗略估计时,可以利用上述 方法判断 *r*<sub>min</sub>;当各层参数无法预估而探测深度又要 求到达基底时,则主要考虑基底的影响,可以依据背 景为基底电阻率的均匀半空间来进行判断。

### 5 结论

1) 利用 CSAMT 与 MT 的响应相对误差来区分 CSAMT 过渡区与远区场是可行的,并且可以精确的 得到各误差限条件下过渡区场的分布范围,进而精确 的给出了均匀半空间中不同误差限要求下最小发收距 *r*<sub>min</sub> 的值以及测量区域的选择范围。对于野外常用的 赤道 *E<sub>x</sub>/H<sub>y</sub>*测量,只有满足 *r*<sub>min</sub>>7δ 时,才能保证数据 误差限仅为 1%。

2) 水平两层条件下,因空间频率特性函数不受观 测角度 φ 的影响,因此地表测量角域的选择与均匀半 空间是一致的。实际工作设计中,对不同的勘探深度, 最小发收距 rmm 的选择具有 3 种不同的情况,并需获 取一定的先验信息,即覆盖层电阻率 $\rho_1$ 、覆盖层厚度  $h_1$  和基底电阻率  $\rho_2$ 。如能预估  $h_1$  和  $\rho_2$ ,则通过 CSAMT 与 MT 的视电阻率相对误差随  $r/\delta_1 \mathcal{D} \delta_1/h_1$ 变 化的分布即可较准确的得到各误差限下最小发收距  $r_{\min}$ 值。如 $h_1$ 和 $\rho_2$ 等参数无法预估,可根据区域地质 情况推知基底类型。当勘探深度远小于 h<sub>1</sub>时,基底的 影响较小, $r_{\rm min}$ 的取值与背景电阻率为 $\rho_{\rm I}$ 的均匀半空 间时的情形一致。当勘探深度与 h<sub>1</sub>相当时,对低阻或 高阻基底,  $r_{min}$  的取值均需大于背景电阻率为 $\rho_1$ 的均 匀半空间时的情形。当勘探深度远大于 h1时,对低阻 基底,  $r_{\min}$  的取值较背景电阻率为 $\rho_1$ 的均匀半空间时 的情形可更小;对于高阻基底,rmin 的取值较背景电 阻率为ρ,的均匀半空间时的情形更大。

3) 多层条件下的情形与两层条件时基本类似。当 勘探深度远大于 h<sub>1</sub>时,低阻层使得误差限对应的可测 范围更大,而高阻层则相反,并且这种影响随着电阻 率差异和层厚的增大而增大。当目标勘探深度范围内 的介质层数较多时,应综合考虑,可利用等效的两层 模型对 r<sub>min</sub>的值进行粗略估计。

#### REFERENCES

[1] 何继善.可控源音频大地电磁法[M]. 长沙:中南大学出版社, 1990: 74-130. HE Ji-shan. Controlled source audio-frequency magnetotellurics[M]. Changsha: Central South University Press, 1990: 74–130.

- [2] 汤井田,何继善.可控源音频大地电磁法及其应用[M].长沙: 中南大学出版社,2005:72-313.
   TANG Jing-tian, HE Ji-shan. Methods and applications of controlled source audio-frequency magnetotellurics[M]. Changsha: Central South University Press, 2005: 72-313.
- [3] 底青云,王 若.可控源音频大地电磁数据正反演及方法应用[M].北京:科学出版社,2008:157-165.
   DI Qing-yun, WANG Ruo. Methods and applications of controlled source audio-frequency magnetotellurics[M]. Beijing: Science Press, 2008: 157-165.
- [4] KAUFMAN A A, KELLER G V. 时间域与频率域电磁测深
  [M]. 北京: 地质出版社, 1987: 13-293.
  KAUFMAN A A, KELLER G V. Time domain and frequency domain electromagnetic sounding[M]. Beijing: Geology Publishing House, 1987: 13-293.
- [5] 朴华荣. 电磁测深法原理[M]. 北京: 地质出版社, 1990: 247-259.

PIAO Hua-rong. Theory of electromagnetic sounding method[M]. Beijing: Geology Press, 1990: 247–259.

[6] 高 文. 大地电磁感应的场源效应[J]. 地球物理学报, 1991, 34(2): 210-215.

KAO D Wen. Line source effects on magnetotellurics responses[J]. Chinese Journal Geophysics, 1991, 34(2): 210-215.

- [7] UMESH C D. Apparent resistivity curves in controlled-source electromagnetic sounding directly reflecting true resistivities in a layered earth[J]. Geophysics, 1995, 60(1): 53–60.
- [8] 曹昌祺.水平分层大地的交流视电阻率[J].地球物理学报, 1978,21(3):248-281.
   CAO Chang-qi. The apparent resistivity for layered earth[J].
   Chinese Journal Geophysics, 1978, 21(3): 248-281.
- [9] 汤井田,何继善.水平电偶源频率测深中全区视电阻率定义的新方法[J].地球物理学报,1994,37(4):543-552.
   TANG Jing-tian, HE Ji-shan. A new method to define the full-zone resistivity in horizontal electric dipole frequency soundings on a layered earth[J]. Chinese Journal Geophysics, 1994, 37(4): 543-552.
- [10] 汤井田,周 聪,张林成. CSAMT 电场 y 方向视电阻率的定 义及研究[J]. 吉林大学学报:地球科学版, 2011, 41(2): 552-558.

TANG Jing-tian, ZHOU Cong, ZHANG Lin-cheng. A new apparent resistivity of CSAMT defined by electric field *y*-direction[J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2011, 41(2): 552–558.

 [11] 汤井田,周 聪,邓晓红. CSAMT 视电阻率曲线对水平层状 大地的识别与分辨[J]. 地质与勘探, 2010, 46(6): 1079-1086.
 TANG Jing-tian, ZHOU Cong, DENG Xiao-hong. Identification and discrimination of the horizontal layered earth by using CSAMT apparent resistivity curves[J]. Geology and Exploration, 2010, 46(6): 1079–1086.

- [12] 王 艳,林 君,周逢道,张文秀. CSAMT 法深部低阻分辨 能力及方法研究[J]. 中国矿业大学学报,2009,38(1):86-90.
  WANG Yan, LIN Jun, ZHOU Feng-dao, ZHANG Wen-xiu.
  Study of resolution and method of CSAMT for the deep low-resistivity[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2009, 38(1): 86-90.
- [13] THEODORE H A, DONALD S S. Audiomagnetotelluric characterization of range-front faults, Snake Range, Nevada[J]. Geophysics, 2011, 76(1): B1–B7.
- [14] WILT M J, MORRISON H F, LEE K H, GOLDSTEIN N E. Electromagnetic sounding in the Columbia Basin, Yakima, Washington[J]. Geophysics, 1989, 54(8): 952–961.
- [15] ZONGE K L. Introduction to CSAMT[M]. Practical Geophysics II, Northwest Mining Association, 1992: 1–6.
- [16] PFAFFHUBER A. Development and test of a controlled source MT method in the frequency range 1 to 50 kHZ[D]. Berlin: Technical University Berlin, 2001: 10–44.
- [17] 岳瑞永,徐义贤.可控源频率域电方位各向异性与近场效应 研究[J].石油地球物理勘探,2004,39(3):342-347.

YUE Rui-yong, XU Yi-xian. Study on electric azimuth anisotropy of controlled source in frequency domain and near-field effects[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2004, 39(3): 342–347.

- [18] 王 若, 王妙月, 卢元林. 高山峡谷区 CSAMT 观测系统研究[J]. 地球物理学进展, 2004, 19(1): 125-130.
   WANG Ruo, WANG Miao-yue, LU Yuan-lin. CSAMT observation system study in high mountain and steep gorge area[J]. Progress in Geophysics, 2004, 19(1): 125-130.
- [19] 陈明生, 闫 述. CSAMT 勘探中场区、记录规则、阴影及场 源复印效应的解析研究[J]. 地球物理学报, 2005, 48(4): 951-958.

CHEN Ming-sheng, YAN Shu. Analytical study on field zones, record rules, shadow and source overprint effects in CSAMT exploration[J]. Chinese Journal Geophysics, 2005, 48(4): 951–958.

 [20] 林 威. CSAM T 法过渡区电磁场的特征[J]. 物探与化探, 2009, 33(2): 148-150.
 LIN Wei. Transition region electromagnetic field characteristics

LIN Wei. Transition region electromagnetic field characteristics of the CSAMT method[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2009, 33(2): 148–150.

(编辑 李艳红)